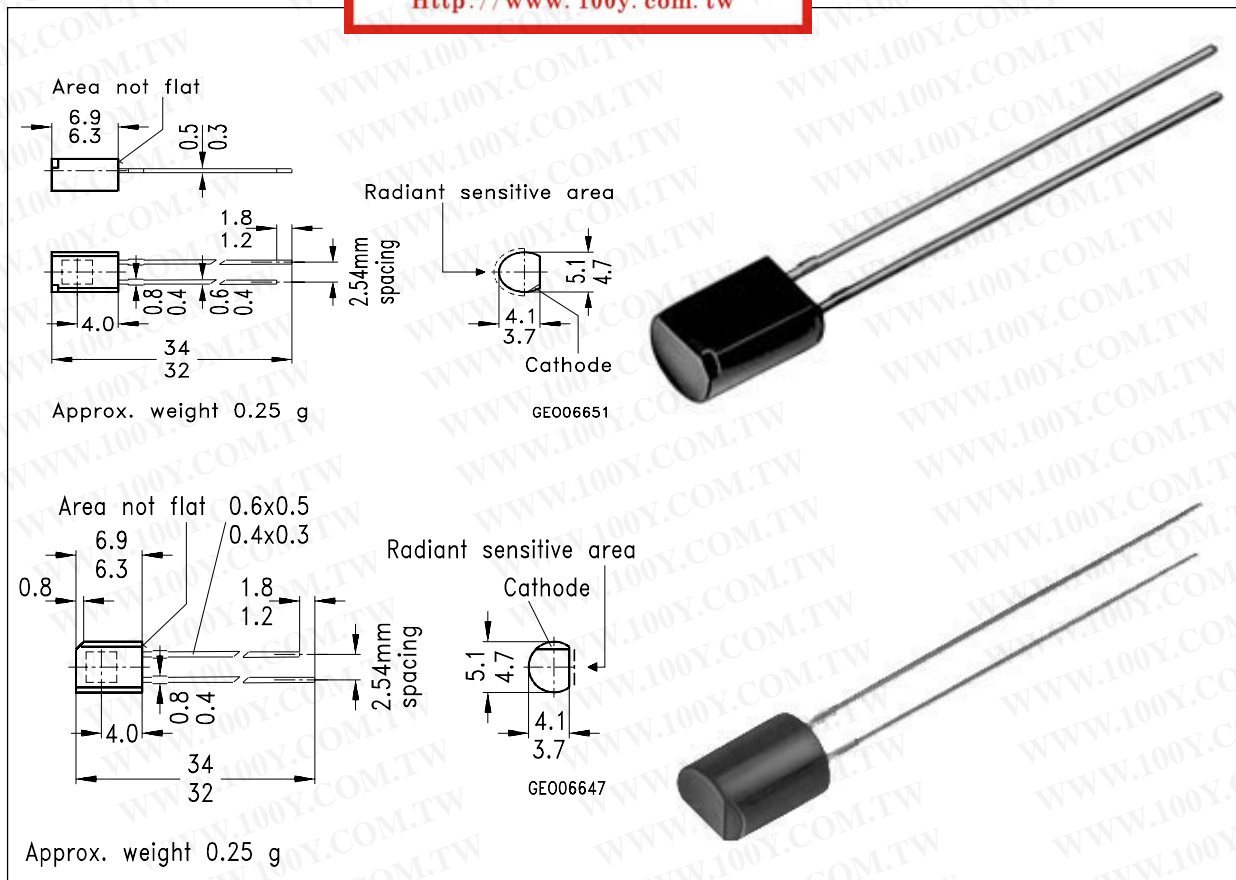


# SIEMENS

## Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter

SFH 205  
SFH 206

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

### Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen bei 950 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Auch gegurtet lieferbar

### Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern, Gerätefernsteuerungen
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb

### Features

- Especially suitable for applications of 950 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- 5 mm LED plastic package
- Also available on tape

### Applications

- IR-remote control of hi-fi and TV sets, video tape recorders, dimmers, remote control of various equipment
- Light reflecting switches for steady and varying intensity

Typ (* ab 4/95) Type (* as of 4/95)	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
SFH 205 (* SFH 205 F)	Q62702-P102	10 A3 DIN 41868 (TO-92-ähnlich), schwarzes Epoxy-Gießharz, Lötspieße im 2.54-mm-Raster ( <sup>1</sup> / <sub>10</sub> ), Kathodenkennzeichnung: Gehäusekerbe  10 A3 DIN 41 868 (similar to TO-92), black epoxy resin, solder tabs 2.54 ( <sup>1</sup> / <sub>10</sub> ) lead spacing, cathode marking: notch at package
SFH 206 (* SFH 206 F)	Q62702-P128	

### Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	-55 ... +80	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3s$ ) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ( $t \leq 3s$ )	$T_S$	230	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	32	V
Verlustleistung, $T_A = 25\text{ °C}$ Total power dissipation	$P_{tot}$	150	mW

### Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ , $\lambda = 950\text{ nm}$ ) Characteristics

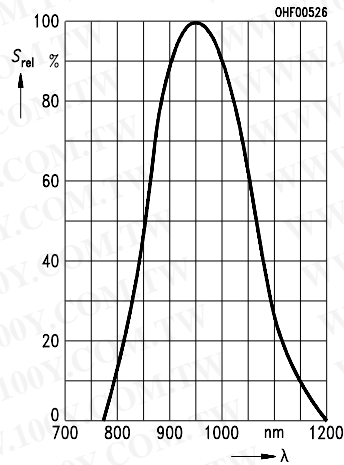
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_R = 5\text{ V}$ , $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$	$S$	25 ( $\geq 15$ )	$\mu\text{A}$
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\text{ max}}$	950	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von $S_{\text{max}}$ Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of $S_{\text{max}}$	$\lambda$	800 ... 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	$A$	7.00	$\text{mm}^2$

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $\lambda = 950\text{ nm}$ )  
**Characteristics**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	2.65 x 2.65	mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip surface to case surface	$H$ $H$	2.3 ... 2.5 1.2 ... 1.4	mm mm
Halbwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 60$	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_R = 10\text{ V}$ Dark current	$I_R$	2 ( $\leq 30$ )	nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity	$S_\lambda$	0.59	A/W
Quantenausbeute Quantum yield	$\eta$	0.77	<u>Electrons</u> Photon
Leerlaufspannung, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ Open-circuit voltage	$V_L$	330 ( $\geq 250$ )	mV
Kurzschlußstrom, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ Short-circuit current	$I_K$	25	$\mu\text{A}$
Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 50\text{ }\Omega$ ; $V_R = 5\text{ V}$ ; $\lambda = 850\text{ nm}$ ; $I_p = 800\text{ }\mu\text{A}$	$t_r, t_f$	20	ns
Durchlaßspannung, $I_F = 100\text{ mA}$ , $E = 0$ Forward voltage	$V_F$	1.3	V
Kapazität, $V_R = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ Capacitance	$C_0$	72	pF
Temperaturkoeffizient von $V_L$ Temperature coefficient of $V_L$	$TC_V$	-2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von $I_K$ Temperature coefficient of $I_K$	$TC_I$	0.18	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_R = 10\text{ V}$	$NEP$	$4.3 \times 10^{-14}$	$\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
Nachweisgrenze, $V_R = 10\text{ V}$ Detection limit	$D^*$	$6.2 \times 10^{12}$	$\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$

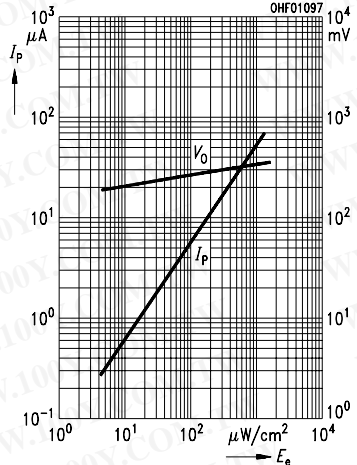
**Relative spectral sensitivity**

$S_{rel} = f(\lambda)$

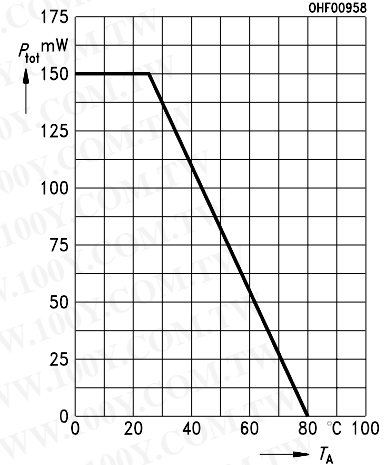


**Photocurrent  $I_P = f(E_e), V_R = 5 V$**

**Open-circuit-voltage  $V_L = f(E_e)$**

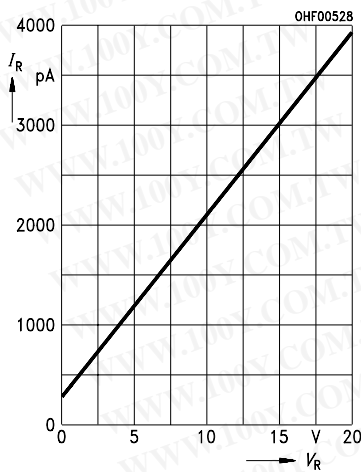


**Total power dissipation  $P_{tot} = f(T_A)$**



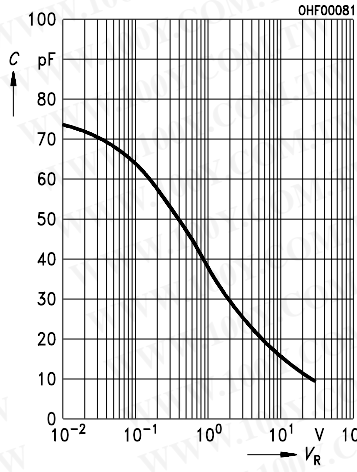
**Dark current**

$I_R = f(V_R), E = 0$



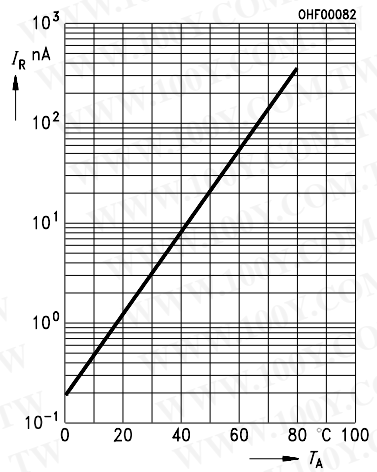
**Capacitance**

$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



**Dark current**

$I_R = f(T_A), V_R = 10 V, E = 0$



**Directional characteristics  $S_{rel} = f(\varphi)$**

